

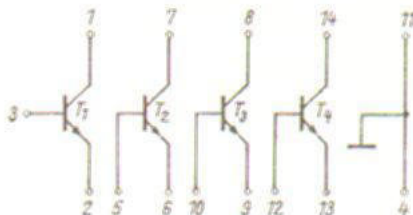
Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transistoren

Bauform 4

Anschlußbelegung

1 Kollektor T1	8 Kollektor T3
2 Emitter T1	9 Emitter T3
3 Basis T1	10 Basis T3
4 Masse	11 Masse
5 Basis T2	12 Basis T4
6 Emitter T2	13 Emitter T4
7 Kollektor T2	14 Kollektor T4

Innere Schaltung



Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}	15 V
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}	20 V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}	5 V
Kollektor-Substrat-Spannung	U_{CJO}	30 V
Kollektorstrom	I_C	10 mA
Basisstrom	I_B	5 mA
Wärmewiderstand für Gesamt I_S	R_{thja}	120 K/W
Betriebstemperaturbereich	θ_a	-25 ... 85 °C
Sperrschichttemperatur	θ_j	125 °C

Kennwerte bei $\vartheta_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ K}$

Gleichstromverstärkung

$U_{CB} = 5\text{ V}, I_E = 1\text{ mA}$

$U_{CB} = 5\text{ V}, I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$

$h_{21E}(T1)$

h_{21E}

c 56 ... 140

d 112 ... 280

e 224 ... 560

c, d, e 30

Verhältnis der Gleichstrom-
verstärkung für alle möglichen
Transistorpaare

$U_{CB} = 5\text{ V}, I_E = 1\text{ mA}$

$\frac{h_{21E}(x)}{h_{21E}(y)}$

0,8 ... 1,25

Differenz der Basis-Emitter-
Spannungen für alle möglichen
Transistorpaare (nur B 340/341)

$U_{CB} = 5\text{ V}, I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$

U_B

$\leq 5\text{ mV}$

Übergangsfrequenz

$U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$

f_T

135 MHz

Rauschfaktor für B 341 D

$I_C = 200\text{ }\mu\text{A}, f = 1\text{ kHz}$

$\Delta f = 100\text{ Hz}, R_G = 2\text{ k}\Omega$

$\leq 6\text{ dB}$